

Биполярни транзистори



Полупроводникови елементи



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през
целия живот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестица във вашето въбение!



стр. 1 от ...

Откриване на транзистора



Първият транзистор (с точков контакт) е открит в AT&T Bell Laboratories



Откриватели: William Shockley, Walter Brittain, и John Bardeen – носители на Нобелова награда по физика 1956

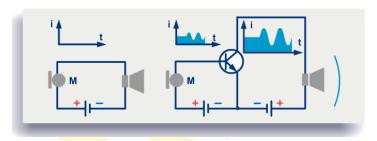


ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подърспа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 2 от ...

Основни свойства



Транзисторът е активен полупроводников елемент. Той позволява с много малък входен сигнал да се управлява значително по-голям по амплитуда и мощност изходен сигнал.

Биполярният транзистор е полупроводников елемент, предназначен за усилване, управление и генериране на електрически сигнали.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия жискот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

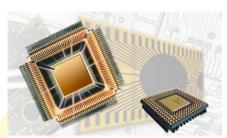
Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 3 от ...

Предимства





Биполярните транзистори заместват вакуумните електронни лампи. Техни основн<mark>и предимства са:</mark>

- твърдо тяло и малки размери
- ниско топлинно излъчване
- 🐤 относително ниска консумирана мощност
- 🛾 висока надеждност.

Тези предимства позволяват миниатюризацията на сложни схеми и проправят път на развитие на микроелектрониката.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 4 от ...

Приложения



Транзисторите се из<mark>по</mark>лзват широко в електронно оборудване в области от джобни калкулатори до промишлени роботи и комуникационни спътници. В допълнение към приложението им като усилватели, те са основни компоненти в осцилаторите, цифровите и аналогови схеми.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компененции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 5 от ...

Цели и предпоставки

Разглеждат се структурата, принципът на действие, характеристиките и параметрите на биполярните транзистори.

Познавате

След изучаване на материала вие би трябвало да:

- Видовете транзистори и тяхната структура
- Схеми на включване на биполярния транзистор
- Режими на работа, характеристики и параметри
- Разбирате
- Принципът на действие на транзистора
- Процесите, протичащи в областите на транзистора
- Значението на максимално допустимите параметри и областта за безопасна работа
- Анализирате Връзката между токовете в транзистора
 - Токовете и напреженията в схеми с транзистори

Предпоставки: полупроводников диод



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфрастружтура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвессиира във вашето бъдеще!



стр. 6 от ...

Структура на транзистора



Биполяният транзистор има 3 области: емитер, база, и колектор;

- Емитерът е силно легиран и инжектира токоносители
- Базата управлява потока на токоносители. Тя е много тънка.
- Колекторът събира токоносителите от базата.



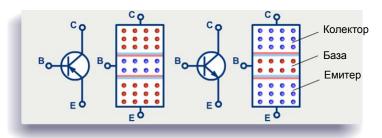
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компененции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 7 от ...

Типове и схемно означение



Съществуват два типа транзистори - *NPN* и *PNP*. Те имат един и същ принцип на действие, но се различават по поляритет на приложените напрежения на преходите и по посока на токовете.

Фигурата илюстрира схемните означения на транзисторите и връзката между електродите и структурата на транзистора. Стрелката върху емитера показва посоката на тока през елемента.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия жисвот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирала от Европейския социалене фод на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 8 от ...

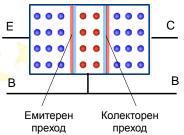
Режими на работа на транзистора

Според поляритета на напреженията, приложени към *рп* преходите, се различават четири режима на работа:

- Активен-нормален режим емитерен преход – право включване колекторен преход – обратно включване
- Режим на отсечка

 емитерен преход обратно включване
 колекторен преход обратно включване
- Режим на насищане

 емитерен преход право включване
 колекторен преход право включване
- Инверсен-активен режим емитерен преход – обратно включване колекторен преход – право включване





ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 9 от ...

Схеми на включване



В зависимост от това, кой от електродите в транзистора е общ между входната, и изходната верига се различават 3 схеми на свързване – обща база (ОБ), общ емитер (ОЕ) и общ колектор (ОК).

В схема обща база, базата е обща между входната и изходната вериги, докато в схема общ емитер емитерът е общ между входната и изходната вериги.

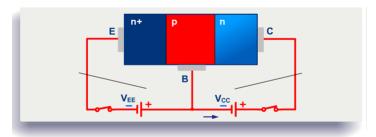


ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подърена на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 10 от ...

Схема обща база – активен режим



Биполярният транзистор нормално е запушен. За да започне да провежда ток, трябва на двата PN прехода да се подадат постоянни напрежения.

В активен режим емитерният преход се поляризира в права посока – т.е. минус на емитера спрямо базата (за *NPN* транзистор), а колекторният преход – в обратна (плюс на колектора спрямо базата).

За *PNP* транзистор, поляритетът на напреженията е противоположен.



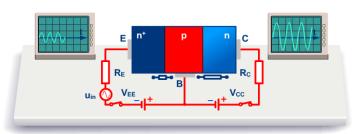
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човещиките ресурси", съфинансирала от Европейския социалене фоц ла Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 11 от ...

Принцип на действие



Принципът на действие на транзистора се основава на явленията, протичащи в два близко разположени и взаимодействащи си *PN* прехода.

Наименованието "transistor" произтича от "trans resistor" – пренася ток от верига с ниско R на право включения емитерен преход към верига с много по-високото R на обратно включения колекторен преход.

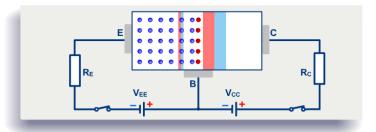


ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подърена на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 12 от ...

Физически процеси в емитера



Ако V_{EE} е по-голям от потенциалната бариера на емитерния преход, започва явлението инжекция. Тък като емитерът е по-силно легиран от базата, инжекцията е едностранен процес и токът през прехода се състои предимно от електрони.

$$\gamma = rac{I_{\scriptscriptstyle nE}}{I_{\scriptscriptstyle E}} < 1$$
 Коефициент на инжекция



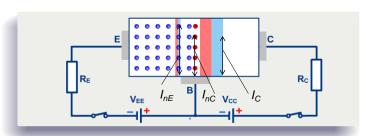
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 13 от ...

Физически процеси в базата



Електронит<mark>е, навлизайки в *P* ба</mark>зата, са неосновни токоносители там. Тъй като б<mark>а</mark>зата е много тънка, незначителен брой електрони **рекомбинират** с дупки в базата и **по-голяма част** от тях достигат до колекторния преход.

$$\chi = rac{I_{nC}}{I_{nE}} < 1$$
 Коефициент на пренасяне



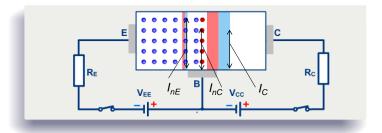
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042 "Организационна и технологична инфраструктура за учене през

целия женовот и развитие на компененции"
Проекты ее осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човещките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашено бъдеще!



стр. 14 от ...

Физически процеси в колектора



Неосновните токоносители, достигнали до колектора, се екстрахират от обратно включения колекторен преход в областта на колектора и преминават в колекторната верига. Ако настъпи лавинен пробив те се умножават в прехода. При липса на пробив M=1.



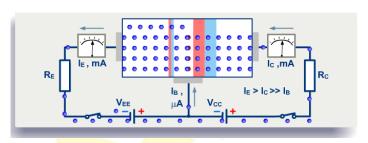
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 15 от ...

Колекторен ток



$$I_C = MI_{nC} = M\chi I_{nC} = M\chi \chi I_{nE} = lpha I_E$$
 $I_C = lpha I_E$ Коефициент на предаване по ток в схема ОБ



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия жисвот и развитие на компетенции"

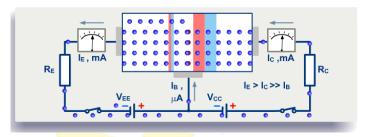
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирала от Европейския социалене фод на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 16 от ...

Токове в транзистора



В транзистора има три тока:

- Емитерният ток е най-големият ток, защото е източник на свободни електрони.
- 😊 Колекторният ток е приблизително равен на емитерния, но по-малък от него.
- ◆ Базисният ток е най-малкият. І_в се измерва в микроампери.



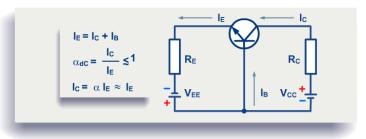
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия жисот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социалене фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 17 от ...

Връзка между токовете в схема ОБ



$$I_C=lpha I_E+I_{CB0}$$
 $I_E=I_C+I_B$ Уравнение на колекторния ток в схема ОБ



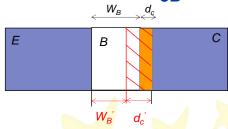
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042 "Организационна и технологична инфраструктура за учене през

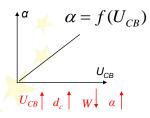
целия женков и развипие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човещките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във сащето бъбеще!



стр. 18 от ...

Влияние на U_{CB} – ефект на Early





$$I_C = lpha I_E + I_{CB0} + rac{U_{CB}}{r_C}$$
 $I_C = f(U_{CB})$ Уравнение на колекторния ток в схема ОБ с отчитане влиянието на U_{CB}

$$I_C = f(U_{CB})$$

$$r_C = \frac{dU_{CB}}{dI_C} = \frac{\Delta U_{CB}}{\Delta I_C} \neq \infty$$

$$\mu_{EC} = -\frac{dU_{EB}}{dU_{CB}}\Big|_{I_E = const}$$



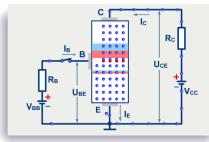
ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

целия живот и развитие на компетенции' Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 19 от ...

Схема общ емитер



Принципът на д<mark>е</mark>йствие на транзистора не зависи от схемата на включване.

$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_{C} = \alpha I_{E} + I_{CB0} = \alpha (I_{C} + I_{B}) + I_{CB0} = \alpha I_{C} + \alpha I_{B} + I_{CB0}$$

$$I_{C}(1-\alpha) = \alpha I_{B} + I_{CB0}$$
 $I_{C} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)} I_{B} + \frac{1}{(1-\alpha)} I_{CB0}$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$I_C = \beta I_B + (1+\beta)I_{CB0}$$



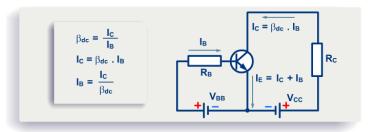
HPOEKT BG051PO001--4,3,04-0042

,Организационна и технологична инфраструктура за учене през Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 20 от ...

Връзка между токовете в схема ОЕ



$$I_C = \beta I_B + (1+\beta)I_{CB0}$$
 Aro $I_B = 0$, $I_C = I_{CE0}$ $I_{CE0} = (1+\beta)I_{CB0}$
$$I_C = \beta I_B + I_{CE0}$$

$$\beta = \frac{I_C - I_{CB0}}{I_B} \approx \frac{I_C}{I_B} >> 1$$

Отношението на колекторния към базисния ток се нарича коефициент на усилване по ток в схема ОЕ, и се означава като β_{dc} или h_{FE} .



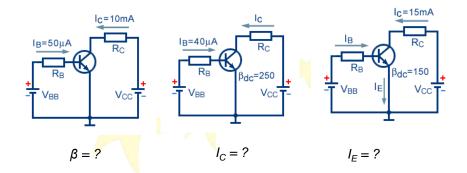
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 21 от ...

Примери





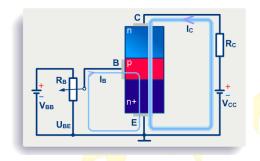
ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия жешоот и развитие на компетенции" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 22 от ...

Коефициент на усилване по ток



Коефициентът на усилване по ток в схема ОЕ е много голям, тъй като $I_C >> I_B$.

За маломощни транзистори, β_{dc} типично е от 100 до 300.

Малка промяна на базисния ток в транзистора предизвиква голямо увеличение на колекторния ток.

Транзисторът в схема ОЕ има голямо усилване по ток, голямо усилване по напрежение и следователно голямо усилване по мощност.



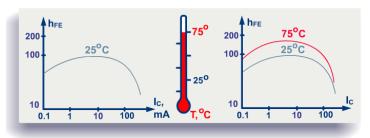
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 23 от ...

Изменение на В



Коефициентът на усилване по ток β се променя в широки граници при изменение на колекторния ток, температурата и при смяна на транзистора.

Поради производствените толеранси, коефициентът на усилване по ток може да варира в диапазон 3:1 при замяна с транзистор от същия тип.

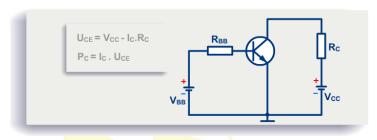


ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подърена на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 24 от ...

Токове и напрежения



$$E_{BB} = U_{BE} + I_B R_B \qquad I_B = \frac{E_{BB} - U_{BE}}{R_B}$$

$$U_{CE} = E_{CC} - I_C R_C \qquad I_C = \frac{E_{CC} - U_{CE}}{R_C} \qquad I_E = I_C + I_B$$

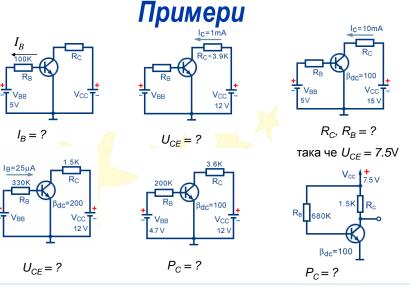


ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042 "Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живоот и развитие на компетенции" Проектът се осъществия с финакоразт поикрета на

целиз живот и развите на компетенции
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдение!



стр. 25 от ...



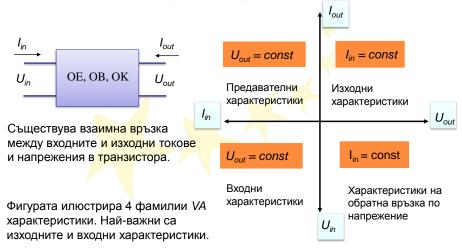
ПРОЕКТ ВG051P0001-4.3.04-0042 "Организационна инехнологична инфраструктура за учене през цели жимот и развитие на компетенции" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма, гразвитие на моещките ресурси",

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 26 от ...

VA характеристики





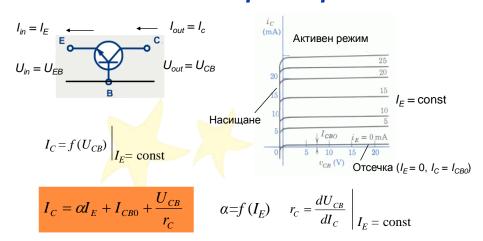
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 27 от ...

ОБ – изходни характеристики





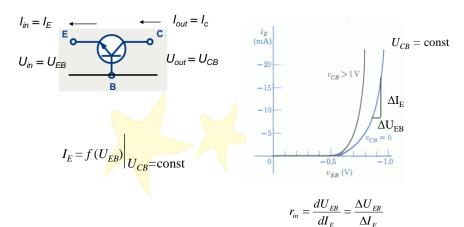
ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия женоот и развитие на компетенции" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 28 от ...

ОБ – входни характеристики





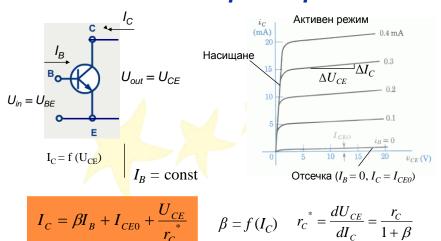
ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042 онна и технологична инфраструктура за учене пре целия живот и развитие на компетенции' Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",





стр. 29 от ...

ОЕ – изходни характеристики





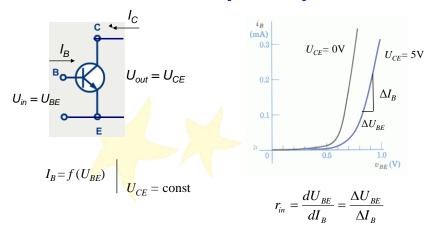
ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042 "Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 30 от ...

ОЕ – входни характеристики





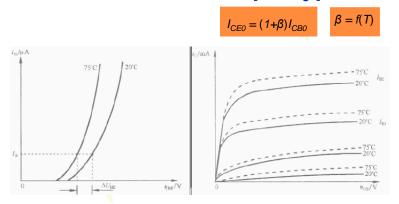
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компененции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 31 от ...

Влияние на температурата



Транзисторът в схема ОЕ е по-температурно зависим спрямо схема ОБ защото I_{CE0} и β се увеличават по-бързо с температурата отколкото I_{CB0} и α .



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия жисвот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирала от Европейския социалене фод на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 32 от ...

Максимално допустими параметри







Максимално допустимите параметри определят границите на токове, напрежения, мощности и други величини в транзистора, които не трябва да се надвишават, за да се гарантира надеждна експлоатация. Те се задават в каталозите от фирмите производители за всеки тип транзистор.

Тези параметри определят нивата, над които елементът се разрушава. Те не би трябвало дори да се доближават за всички режими на работа. В противен случай елементът може да не функционира нормално или да се съкрати срокът му за експлоатация.



ПРОЕКТ ВG051PO001--4.3.04-0042 целия живот и развитие на компетенции' Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 33 от ...

Максимална мощност

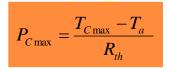
- ♦ Мах температура на прехода $T_{Cmax} < T_i$, където $n = p = n_i$
- ◆ Мах мощност в колектора Р_{Стах}

$$P = U_C I_C \quad$$
 Мощност, отделена в колекторния преход

$$P = rac{T_C - T_a}{R_{th}}$$
 Мощност, разсеяна в околната среда

Когато се отделя мощност в колекторния преход, температурата му $T_{\rm C}$ се повишава. По-голяма мощност – по-висока температура.

$$UI = \frac{T_C - T_a}{R_{th}}$$



Отделената мощност трябва винаги да е помалка от тах допустимата P_{Cmax} . В противен случай елементът се разрушава.



HPOEKT BG051PO001--4,3,04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 34 от ...

Отвеждане на топлината



Отделената в прехода топлина се отвежда през корпуса на транзистора.

Биполярните транзи<mark>ст</mark>ори се срещат с пластмасови или метални корпуси според разсейваната от тях мощност.

Средномощните транзистори имат метална плоча до корпуса си. При мощните корпусът е метален за по-бързото разсейване на топлината.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компененции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



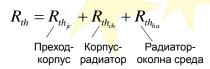
стр. 35 от ...

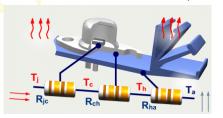
Топлинно съпротивление

Топлинното съпротивление R_{th} показва ефективността при отделяне на топлината от транзистора и се измерва в K/W или в ${}^{\circ}C/W$.

$$R_{th} = R_{th_{jc}} + R_{th_{ca}} \qquad R_{th_{ca}} >> R_{th_{jc}} \qquad \qquad P_{C \max} = \frac{T_{C \max} - T_{a}}{R_{th}}$$

Колкото по-малко е топлинното съпротивление толкова по-голяма е максимално допуст<mark>и</mark>мата мощност.







ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия жисот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Осърганизационня в пределати подкрепа на пределати на пределати подкрепа на пределати на пределат

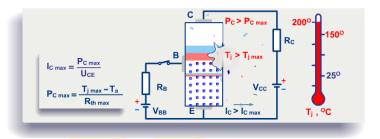
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз *Инвесстира във вашетю бъдеще!*



Радиатор

стр. 36 от ...

Максимален колекторен ток



Максималният колекторен ток $I_{\rm Cmax}$ показва максималният ток, който може да протече през транзистора без да се надвиши $P_{\rm Cmax}$.

$$U_{CE}I_{C\max} = P_{C\max} = \frac{T_{C\max} - T_a}{R_{th}}$$



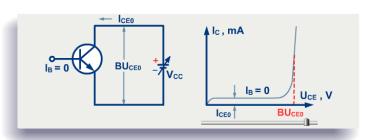
ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 37 от ...

Пробиви в транзистора



 $U_{\it BR_{\it CE}\,0}$ представлява напрежението между емитера и колектора, при отворена база. Това е пробивното напрежение в схема ОЕ.

 $U_{\it BR_{\it CB\,0}}$ представлява напрежението между колектора и база, при отворен емитер. Това е пробивното напрежение в схема ОЕ.





ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подърена на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 38 от ...

Област на безопасна работа



Ако работната точка е избрана в областта на безопасна работа (ОБР), това гарантира, че по време на експлоатация няма да се надвишат максимално-допустимите параметри.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организациони и мехнологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 39 от ...

Влияние на температурата



С увеличаване на температурата границите на областта на безопасна работа се снижават.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042

"Организациони и технологична инфраструктура за учене през целия жисвот и развитие на компетенции"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирала от Европейския социалене фод на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



стр. 40 от ...

Тестване на транзистора



Съпротивлението на PN преходите може да се провери с омметър – трябва да е малко при право включване и голямо при обратно. При тестване на транзистор този подход се използва за всеки от двата PN прехода.



ПРОЕКТ BG051PO001--4.3.04-0042
"Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Инвестица във вашето бъдение!



стр. 41 от ...